

*** 主要用途：**

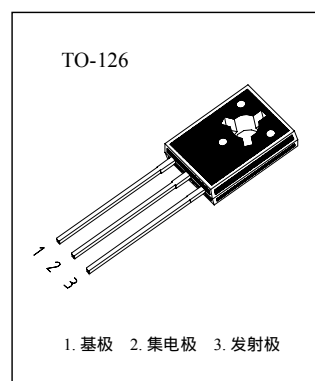
电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

*** 主要特点：**

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

*** 封装形式：**

TO-126



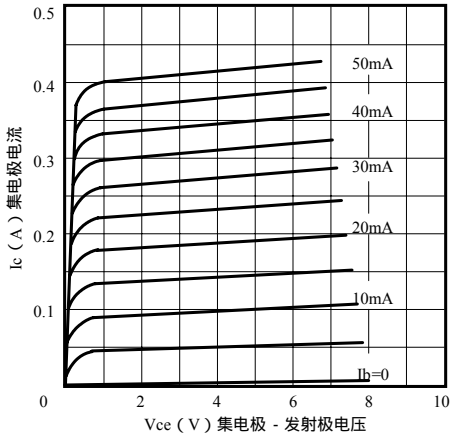
极限值： ($T_c=25$)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极 - 发射极击穿电压	BV_{CEO}	400	V
集电极 - 基极击穿电压	BV_{CBO}	600	V
发射极 - 基极击穿电压	BV_{EBO}	9	V
最大集电极直流电流	I_{cm}	1.5	A
最大耗散功率	P_{cm}	30	W
最高结温	T_{jm}	150	
贮存温度	T_{stg}	- 55 ~ 150	

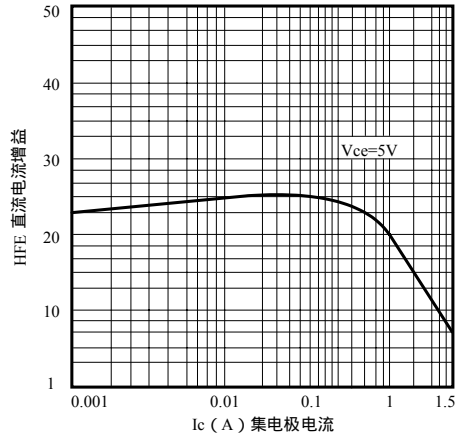
电特性： ($T_c=25$)

参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
集电极 - 发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_c=1mA$; $I_B=0$	400		V
集电极 - 基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_c=1mA$; $I_E=0$	600		V
发射极 - 基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA$; $I_C=0$	9		V
集电极 - 发射极反向漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=350V$; $I_B=0$		20	μA
集电极 - 基极反向漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=550V$; $I_E=0$		10	μA
发射极 - 基极反向漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V$; $I_C=0$		10	μA
共发射极直流电流增益	H_{FE}	$V_{CE}=5V$; $I_C=0.2A$	10	35	
集电极 - 发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1A$; $I_B=0.5A$		0.6	V
下降时间	t_f	$I_C=1A$; $I_{B1}=I_{B2}=0.2A$; $V_{CE}=300V$		0.3	μS
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V$; $I_C=0.1A$; $f=1MHz$		8	MHz

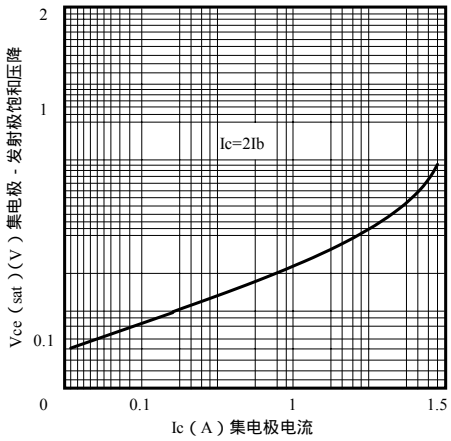
静态输出特性



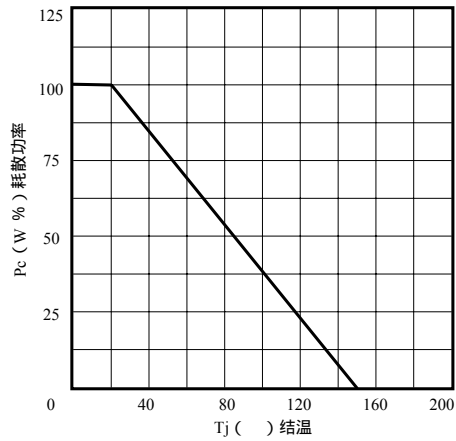
HFE 直流电流增益 - I_c 集电极电流



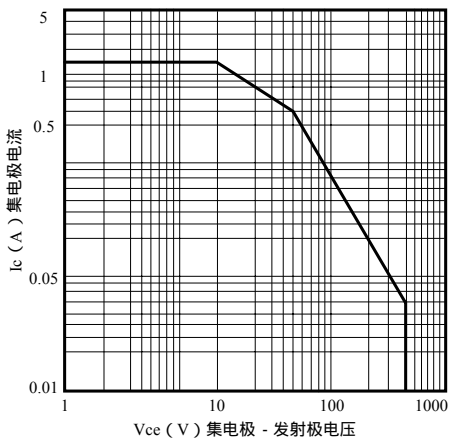
$V_{ce(sat)}$ 集电极 - 发射极饱和压降 - I_c 集电极电流



P_c 耗散功率 - T_j 结温

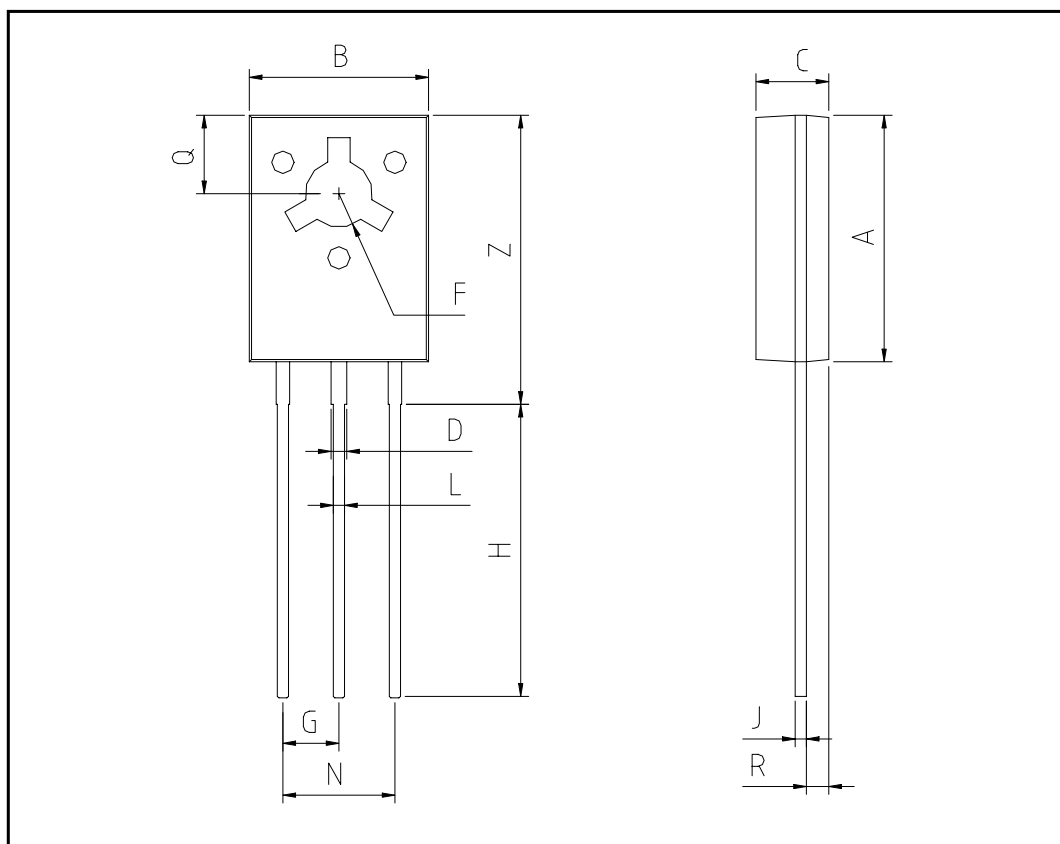


SOA (DC) 安全工作区



TO - 126 外形尺寸图

单位：mm



符号	最小值	典型值	最大值
A	9.0	10	11
B	7.05	8	8.05
C	2.4	2.5	2.8
D	1.4	1.5	1.6
F	3.15	φ3.2	3.25
G		2.3	
H		13	
J	0.48	0.5	0.55
K			
L	0.65	0.75	0.85
N		4.6	
P			
Q	3.8	3.9	4.0
R	0.9	1	1.1
S			
Z	13.5	14	14.5